



汕头华汕电子器件有限公司

NPN SILICON TRANSISTOR

H1246

对应国外型号
2SD1246

主要用途

大电流驱动。

极限值 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

T_{stg} ——贮存温度.....	-55~150
T_j ——结温.....	150
P_C ——集电极耗散功率.....	750mW
V_{CBO} ——集电极—基极电压.....	30V
V_{CEO} ——集电极—发射极电压.....	25V
V_{EB0} ——发射极—基极电压.....	6V
I_C ——集电极电流.....	2A
I_{CP} ——集电极电流.....	5A

TO-92



1—发射极, E
2—集电极, C
3—基极, B

电参数 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单 位	测 试 条 件
BV_{CBO}	集电极—基极击穿电压	30			V	$I_C=10\mu\text{A}$, $I_E=0$
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	25			V	$I_C=1\text{mA}$, $I_B=0$
BV_{EB0}	发射极—基极击穿电压	6			V	$I_E=10\mu\text{A}$, $I_C=0$
$H_{\text{FE}}(1)$	直流电流增益	100		560		$V_{\text{CE}}=2\text{V}$, $I_C=100\text{mA}$
$H_{\text{FE}}(2)$		65	130			$V_{\text{CE}}=2\text{V}$, $I_C=1.5\text{A}$, *
$V_{\text{CE}}(\text{sat})$	集电极—发射极饱和电压		0.18	0.4	V	$I_C=1.5\text{A}$, $I_B=75\text{mA}$, *
$V_{\text{BE}}(\text{sat})$	基极—发射极饱和电压		0.85	1.2	V	$I_C=1.5\text{A}$, $I_B=75\text{mA}$, *
I_{CB0}	集电极—基极截止电流			100	nA	$V_{\text{CB}}=20\text{V}$, $I_E=0$
I_{EB0}	发射极—基极截止电流			100	nA	$V_{\text{EB}}=4\text{V}$, $I_C=0$
f_T	特征频率		150		MHz	$V_{\text{CE}}=10\text{V}$, $I_E=50\text{mA}$
C_{ob}	共基极输出电容		19		pF	$V_{\text{CB}}=10\text{V}$, $I_E=0$, $f=1\text{MHz}$

* pulse

分档及其标志

R

S

T

U

100—200

140—280

200—400

280—560